PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009676 1

電界効果トランジスタ

25K247

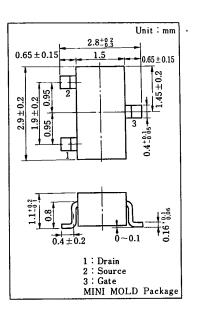
シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

広帯域低雑音増幅/Wide-Band, Low-Noise Amplifier

- ■特 徵/Features
- 入力容量 C_{iss} が小さい。/Low C_{iss}
- 相互コンダクタンスgmが大きい。/High gm

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
ゲート・ドレイン電圧	V _{GPO}	15	V
ゲート・ソース電圧	-V _{gso}	15	v
ドレイン電流	ID	20	mA
ゲート電流	I _G	5	mA
許容損失	PD	150	mW
チャンネル部温度	T _{ch}	100	°C
保存温度	T _{stg}	$-55 \sim +125$	Ĉ



■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

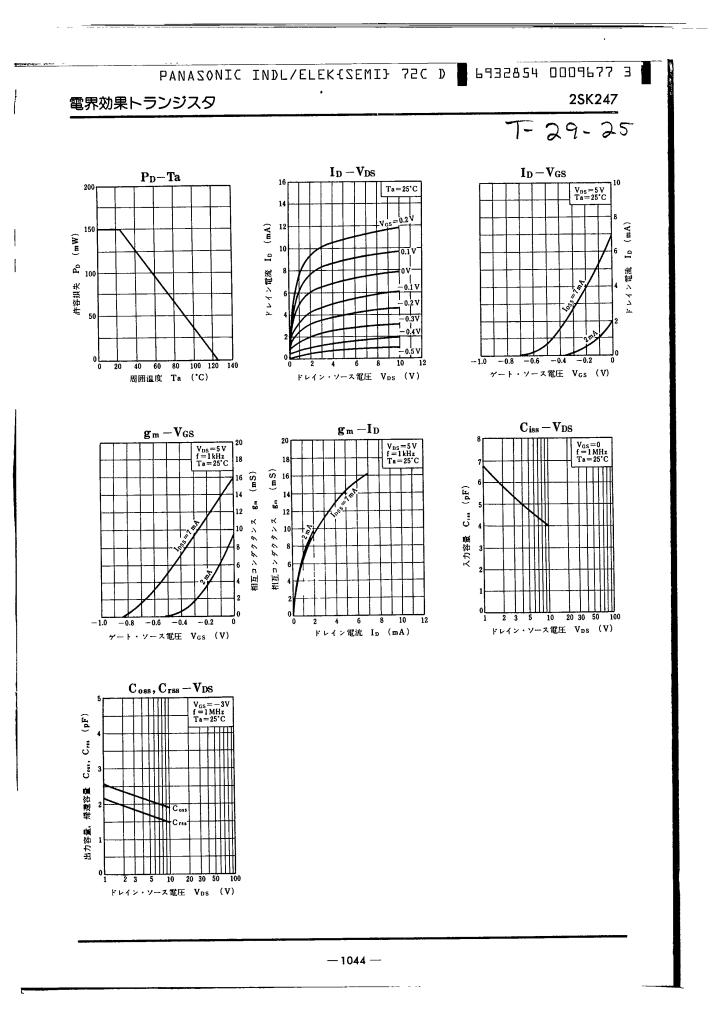
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
 ドレイン電流	I _{DSS} *	$V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0$	0.5		12	mA
ゲートしゃ断電流	I _{GSS}	$-V_{GS} = 7 V, V_{DS} = 0$			2 .	nA
ゲート・ドレイン電圧	-V _{gdo}	$I_D = 10 \ \mu A$	15			v
ゲート・ソース電圧	-V _{GSO}	$I_{g} = 10 \ \mu A$	15			v
ゲート・ソースしゃ断電圧	-V _{GSC}	$V_{DS} = 5 V, I_D = 100 \mu A$			3	v
相互コンダクタンス	gm	$V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0, f = 1 kHz$	3			mS
入力容量	C _{tss}	$V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0, f = 1 MHz$		7.5		pF

* I_{DSS} ランク分類/I_{DSS} Classifications

Class	Р	Q	R	S
I_{DSS} (mA)	0.5~1.5	1~3	2~6	4~12
Marking Symbol	1LP	1LQ	1LR	1LS

2SK247

T-29-25



PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009678 5

電界効果トランジスタ

25K301

Г

シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

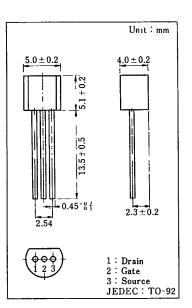
低周波増幅用,スイッチング用/AF Amplifier, Switching

■特 徵/Features

- 低雑音, 高利得/Low-noise, high gain
- ゲート・ドレイン電圧 V_{GDO} が高い。/High V_{GDO}

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Item	Symbol	Value	Unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DSX}	55	V
ゲート・ドレイン電圧	-V _{gdo}	55	V
ゲート・ソース電圧	$-V_{GSO}$	55	v
ドレイン電流	ID	30	mA
ゲート電流	I _G	10	mA
許容損失	PD	250	mW
接合部温度	T,	125	°C
保存温度	T _{stg}	$-55 \sim +125$	C



2SK301

T-29-25



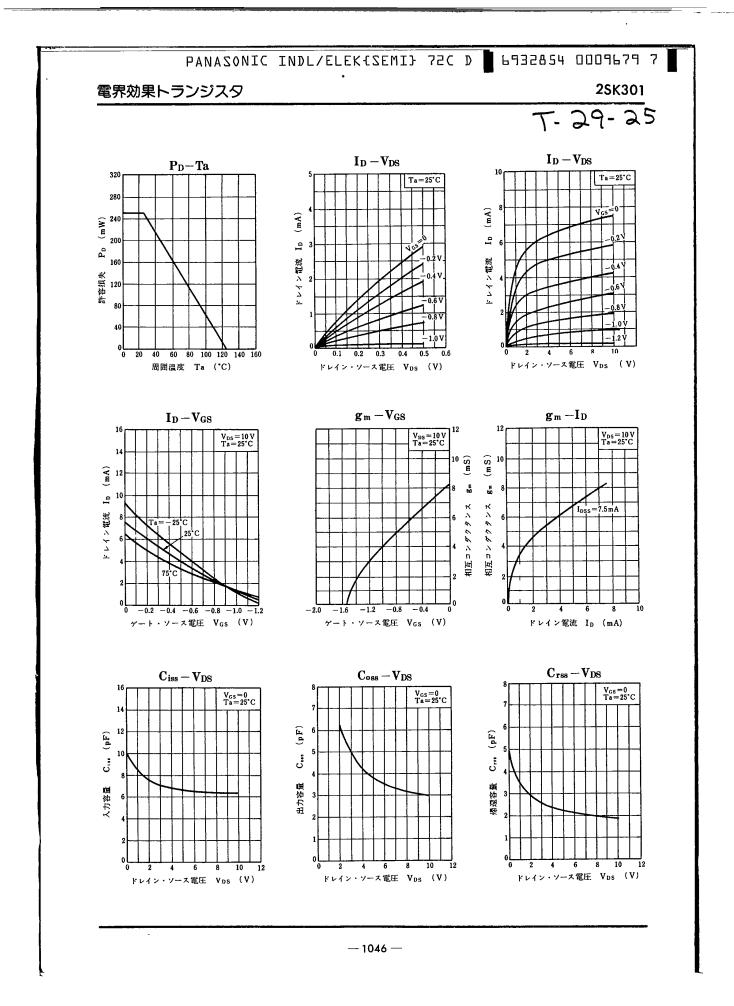
電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25 ℃)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン電流	I _{DSS} *	$V_{DS} = 10 V, V_{GS} = 0$	0.5	····	20	mA
ゲートしゃ断電流	-I _{css}	$-V_{GS}=30$ V, $V_{DS}=0$			10	nA
ゲート・ドレイン電圧	$-V_{GDS}$	$-I_{\rm G} = 100 \ \mu {\rm A}, \ {\rm V}_{\rm DS} = 0$	55			V
ゲート・ソースしゃ断電圧	-V _{gsc}	$V_{DS} = 10 \text{ V}, \ I_D = 10 \mu \text{ A}$			5	v
相互コンダクタンス	gm	$V_{DS} = 10 V, V_{GS} = 0, f = 1 kHz$	2.5	7.5		mS
入力容量	C ₁₅₅	$V_{ps} = 10 V$, $V_{cs} = 0$, $f = 1 MHz$		6.5		pF
帰還容量	Crss	$v_{DS} = 10 v, v_{GS} = 0, 1 = 1 W1112$		1.9		pF
雑音指数	NF	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0, R_g = 100k\Omega, f = 120Hz$		0.5		dB

* I_{DSS} ランク分類/I_{DSS} Classifications

Class	Р	Q	R	S
I _{DSS} (mA)	1~3	2~6.5	5~12	10~20

Į



谗

PANASONIC INDL/ELEK{SEMI} 72C D 6932854 0009680 3

電界効果トランジスタ

25K316

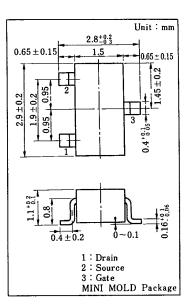
シリコン N チャンネル接合形 / Si N-Channel Junction

ビデオカメラ初段増幅用/Video Camera First Stage Amplifier

- ■特 徵/Features
- 入力容量 C_{lss} が小さい。∕Low C_{lss}
- 相互コンダクタンス gm が高い。/High gm

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Item	Symbol	Value	Unit
ゲート・ドレイン電圧	-V _{gdo}	10	V
ゲート・ソース電圧	-V _{sco}	10	v
ドレイン電流	ID	50	mA
ゲート電流	I _G	5	mA
許容損失	Po	200	mW
チャンネル部温度	T _{ch}	100	C
保存温度	T _{stg}	$-55 \sim +125$	°C



■ 電気的特性/Electrical Charateristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ゲート・ドレイン電圧	-V _{GDO}	$I_{\rm g} = 100 \ \mu {\rm A}$	10			V
ゲート・ソース電圧	-V _{gso}	$I_{\rm g} = 100 \mu {\rm A}$	10			V
ゲートしゃ断電流	- I _{GSS}	$-V_{GS} = 7 V, V_{DS} = 0$			2	nA
ドレイン電流	I _{DSS} *	$V_{\rm DS} = 5 \rm V, \ V_{\rm GS} = 0$	5		24	mA
ゲート・ソースしゃ断電圧	-V _{GSC}	$V_{\rm DS} = 5 \rm V, \ I_{\rm D} = 100 \mu \rm A$			3	V
相互コンダクタンス	gm	$V_{DS} = 5 V, V_{GS} = 0, f = 1 kHz$	15			mS
入力容量	Clss	$V_{DS} = 5 V, I_D = 5 mA, f = 1MHz$	ļ		5	pF

* I_{DSS} ランク分類/I_{DSS} Classifications

Class	Р	Q
I _{DSS} (mA)	5~16	14 - 24
Marking Symbol	1KP	1KQ

2SK316

T-29-25

